

日程表 (会場別) 1

早稲田大学

会場名	収容人数	3月15日(木)		3月16日(金)		3月17日(土)		3月18日(日)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
A (8号館)	A1 地下1-B101	295	JSAP-KPS Joint Symposium "Japan-Korea Symposium on Photovoltaics"	13.6 Siデバイス/集積化技術	13.6 Siデバイス/集積化技術	13.6 Siデバイス/集積化技術	13.6 Siデバイス/集積化技術	13.1 基礎物性・評価	13.1 基礎物性・評価	
	A2 地下1-B102	295	講演奨励賞贈呈式	業績賞受賞記念講演	JJAP これまでの50年、これからの50年	3.1 物理光学・光学基礎	3.1 物理光学・光学基礎	7.4 ナノインプリント	7.4 ナノインプリント	
	A3 1F-106	775	17 ナノカーボン(ショート口頭講演)	これからのスピントロニクスを担う材料の新展開	17.1 成長技術	17.1 成長技術	17.1 成長技術	17.2 構造制御・プロセス		
	A4 3F-308	169	チュートリアル「光インターコネクションの基礎と展望」	光ナノインプリントの半導体応用		13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ
	A5 3F-309	72	チュートリアル「原子炉の物理と放射線の計測」		13.2 半導体表面	13.7 シミュレーション		素子間信号伝達構造界面の物理化学、その現状と今後	13.4 配線技術	
	A6 3F-310	72	チュートリアル「磁気光学効果を利用したセンシング」		8 プラズマエレクトロニクス(ショート口頭講演)	8.5 プラズマナノテクノロジー	13.5 Siプロセス技術	13.5 Siプロセス技術	13.5 Siプロセス技術	
	A7 4F-411	85	チュートリアル「マイクロプラズマの基礎と応用」		8.1 プラズマ生成・制御	8.1 プラズマ生成・制御	8 プラズマエレクトロニクス(ショート口頭講演) 8.4 プラズマエッチング	8.4 プラズマエッチング	8.2 プラズマ診断・計測	
	A8 4F-412	85	チュートリアル「スピントロニクスの基礎」		15.3 III-V族エピタキシャル結晶	15.3 III-V族エピタキシャル結晶	15.3 III-V族エピタキシャル結晶	15.6 IV族系化合物	15.6 IV族系化合物	15.6 IV族系化合物
B (7号館)	B1 2F-209	171		11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	11.4 アナログ応用および関連技術	11.4 アナログ応用および関連技術	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	
	B2 2F-218	240	シリサイド系熱電材料は排熱発電の本命になり得るか〜実力と課題を知る〜	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.4 デバイス応用	17.4 デバイス応用		
	B3 2F-219	167	9.3 ナノエレクトロニクス	ナノワイヤ研究の最新動向	9.3 ナノエレクトロニクス	9.1 誘電材料・誘電体 9.3 ナノエレクトロニクス	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	9.5 新機能材料・新物性	9.2 微粒子・粉体
	B4 2F-220	240		10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー、金属磁性体等)	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー、金属磁性体等)	10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術	10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	
	B5 2F-221	63		7.7 微小電子源	7.2 電子顕微鏡、評価、測定、分析	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	7.1 X線技術	7.1 X線技術	
	B6 2F-222	63		16.1 基礎物性・評価	16.1 基礎物性・評価	16.3 シリコン系太陽電池	16.2 プロセス技術・デバイス	7.5 ビーム・光励起表面反応 7.8 ビーム応用一般・新技術		
	B7 3F-319	240	田中昭二先生追悼シンポジウム「高温超伝導研究開発の25年と将来 - 発見前夜から超伝導デバイス・線材開発まで -」	動き始めた超伝導技術 - 風力発電と超伝導医療	11.1 基礎物性	11.1 基礎物性	11.1 基礎物性	11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	
	B8 3F-321	216	中性子・X線のコラレーションによる薄膜・多層膜の埋もれた界面の解析の新しい展開		8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.2 プラズマ診断・計測 8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.3 プラズマ成膜・表面処理	
	B9 4F-414	159	3.2 材料光学	ポスト3.11の防災光波センシング	3.6 生体・医用光学	3.6 生体・医用光学	3.8 光学新領域	3.4 計測光学	3.4 計測光学	3.4 計測光学
	B10 4F-418	540	3.3 機器・デバイス光学	デジタルオプティクス	3.5 情報光学	日本光学会総会 3.5 情報光学	15.4 III-V族窒化物結晶	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池
	B11 4F-419	156		二次イオン質量分析法の新展開 - はやぶさからバイオテクノロジーまで -	10.4 半導体・有機・量子スピントロニクス	10.4 半導体・有機・量子スピントロニクス	3.7 近接場光学	3.7 近接場光学	3.7 近接場光学	3.7 近接場光学
C (10号館)	C1 1F-109	580	スクール機能性酸化物入門〜理論、加工・計測技術、応用〜		スクール半導体リソグラフィ技術の基礎		14.6 化合物太陽電池	14.6 化合物太陽電池	14.6 化合物太陽電池	14.6 化合物太陽電池
	C2 1F-106	54				1.8 計測技術 1.9 計測標準	1.5 エネルギー変換・貯蔵 1.6 資源・環境	1.7 磁場応用		
	C3 1F-107	54		重力応用研究グループ企画「重力場応用研究」	1.3 新技術	様々な衝撃現象と技術開発	1.3 新技術	1.1 応用物理一般	1.1 応用物理一般	1.1 応用物理一般
	C4 1F-108	54			2.3 放射線応用・発生装置・新技術	2.3 放射線応用・発生装置・新技術 2.2 検出器開発	2.2 検出器開発	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	
E (14号館)	E1 地下1-B101	243		不純物機能活性型材料の機能制御とデバイス応用: 機能核モデル	14.1 探索的材料物性	14.1 探索的材料物性	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.1 探索的材料物性
	E2 1F-101	265	エネルギー・環境研究会主催「グリーンソサイエティを拓くエネルギー革新技術〜太陽光利用からエネルギーシステムまで〜」		14.5 光物性・発光デバイス	14.5 光物性・発光デバイス	14.5 光物性・発光デバイス	14.5 光物性・発光デバイス	14.3 プロセス技術・界面制御	14.3 プロセス技術・界面制御
	E3 1F-102	265		電磁メタマテリアルの最近の進展と将来展望	合同セッションL(MEMS、NEMSの基礎と応用: 異種機能集積化)	合同セッションL(MEMS、NEMSの基礎と応用: 異種機能集積化)	14.4 超高速・機能デバイス	14.4 超高速・機能デバイス	4.1 量子光学・原子光学	4.6 レーザー分光応用・計測
	E4 2F-201	742	特別シンポジウム「元素戦略と応用物理」		合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」		
	E5 4F-401	160		4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象				
	E6 4F-402	160		4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス				
	E7 4F-403	160		福島原発事故から一年間を経て〜放射線・放射能の測定から除染、そして復興〜	12.3 電子機能材料・デバイス	12.3 電子機能材料・デバイス				
	E8 5F-501	160		プラズマエレクトロニクス分科会企画「カーボンナノ材料プラズマプロセスの将来展望〜合成から機能化まで〜」	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	
	E9 5F-502	160		多元化合物の新規物性と応用	レーザービームシェーピングの新展開	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー

日程表 (会場別) 2

早稲田大学

会場名		収容人数	3月15日 (木)		3月16日 (金)		3月17日 (土)		3月18日 (日)	
			午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
F (15号館)	F1 地下1-02	144		12.6 高分子・ソフトマテリアル 12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.10 ナノバイオテクノロジー	12.10 ナノバイオテクノロジー	12.10 ナノバイオテクノロジー	12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」	12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」	12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」
	F2 地下1-03	180		重力波観測用巨大干渉計の設計と建設	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空
	F3 地下1-04	180		3D原子イメージング技術の新展開	5.1 半導体レーザー・発光/受光素子	5.1 半導体レーザー・発光/受光素子	5.4 光ファイバー	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜
	F4 1F-101	534		分極反転が拓く光制御の未来	5.2 光記録/ストレージ	5.3 光制御	5.3 光制御	5.3 光制御	5.3 光制御	5.3 光制御
	F5 1F-102	404	6.6 プローブ顕微鏡	薄膜・表面物理分科会企画「軽元素ワイドギャップ薄膜のヘテロエピタキシャル成長と高機能化界面」	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.1 強誘電体薄膜	強誘電体薄膜のエネルギー分野への展開	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜
	F6 2F-201	403	ポストスケール時代における次世代革新的デバイスおよび材料の探索		6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス
	F7 2F-202	401	12.1 作製技術	12.1 作製技術	薄膜シリコン太陽電池と有機薄膜太陽電池のサイエンス	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.1 作製技術	12.8 有機EL	12.8 有機EL	
	F8 2F-203	403		有機分子・バイオエレクトロニクス分科会企画：最先端バイオイメージング M&BE division special symposium: Leading Edge of Bio-imaging	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.5 液晶	12.5 液晶
	F9 3F-301	612		空間多重光ファイバ伝送と光インターコネクションの最新技術動向	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	12.4 光機能材料・デバイス	12.4 光機能材料・デバイス
	F10 3F-302	612	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	ナノひずみエレクトロニクス～半導体ナノひずみの新規デバイス応用と高分解能測定～	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」
	F11 4F-401	751		窒化物半導体における特異構造の理解と制御	15.7 エピタキシーの基礎 15.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶	15.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶	15.1 バルク結晶成長	15.8 結晶評価、ナノ不純物・結晶欠陥	15.2 II-VI 族結晶	
	F12 4F-402	751		15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶
S	大隈講堂		特別シンポジウム「応用物理とグリーンサイアティ―発電、蓄電、送電、省電技術の現状と展望―」							
M	小野記念講堂		諮問委員会 業績賞授賞式							
D (11号館)	DP1 ∪ DP7		[前半] 17 ナノカーボン		[前半] 7.6 イオンビーム一般 9.4 熱電変換	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等) 10.3 GMR・TMR 磁気記録技術	[前半] 7.1 X線技術 7.3 リソグラフィ 15.3 III-V族エピタキシャル結晶 15.7 エピタキシーの基礎	[後半] 8 プラズマエレクトロニクス 9.5 新機能材料・新物性 15.1 バルク結晶成長 15.2 II-VI 族結晶		
				15.4 III-V 族窒化物結晶	[後半] 9.3 ナノエレクトロニクス 10.2 スピントロクスピン流・回路・測定技術	10.4 半導体・有機・光子 量子スピントロニクス 15.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶 15.6 IV 族系化合物	[後半] 10.4 半導体・有機・光子 量子スピントロニクス 9.5 新機能材料・新物性 15.1 バルク結晶成長 15.2 II-VI 族結晶			
G (興風館)	GP1 ∪ GP18	ポスターセッション	[前半] 13.3 絶縁膜技術 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 合同セッションL (MEMS, NEMS)の基礎と応用：異種機能集積化)		[前半] 3.7 近接場光学 6.1 強誘電体薄膜 8 プラズマエレクトロニクス 9.1 誘電材料・誘電体 13.2 半導体表面 13.5 Siプロセス技術 14.2 超薄膜・量子ナノ構造 14.6 化合物太陽電池	3.4 計測光学 3.5 情報光学 3.6 生体・医用光学 4.4 超高速・高強度レーザー 6.2 カーボン系薄膜 6.4 薄膜新材料 6.5 表面物理・真空 12.8 有機EL 12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」 13.4 配線技術 16.1 基礎物性・評価	[前半] 3.8 光学新領域 4.1 量子光学・原子光学 4.6 レーザー分光応用・計測 6.6 プローブ顕微鏡 11.1 基礎物性 11.2 薄膜、厚膜、テープ製プロセスおよび結晶成長 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデバイス応用 12.1 作製技術 12.5 液晶	[後半] 1.8 計測技術 1.9 計測標準 5.1 半導体レーザー・発光/受光素子 5.4 光ファイバー 12.4 光機能材料・デバイス 12.10 ナノバイオテクノロジー	1.3 新技術 1.4 トライボロジー 1.5 エネルギー変換・貯蔵 5.3 光制御 12.7 生物・医用工学・バイオチップ 13.6 Siデバイス/集積化技術 14.4 超高速・機能デバイス 14.5 光物性・発光デバイス	
			4.2 フォトニックナノ構造・現象 4.5 テラヘルツ全般 非線型光学 6.3 酸化物エレクトロニクス	[後半] 3.2 材料光学 3.3 機器・デバイス光学 4.3 レーザー装置・材料 4.7 レーザー・プロセッシング 12.2 評価・基礎物性 12.3 電子機能材料・デバイス 12.6 高分子・ソフトマテリアル 12.9 有機トランジスタ	1.2 教育 13.7 シミュレーション	[後半] 11.4 アナログ応用および関連技術 12.11 特定テーマ「有機太陽電池」 16.3 シリコン系太陽電池		[後半] 13.1 基礎物性・評価 14.1 探索的材料物性 14.3 プロセス技術・界面制御		